

Silizium-pnp-Legierungstransistor

Der Transistor SC 105 ist ein Si-pnp-Flächentransistor in der Bauform B 1 nach TGL 11811 (entspricht TO 5).
Einsatz vornehmlich für hochwertige NF-Stufen.

Statische Kennwerte (für $\theta_a = 25$ °C — 5 grd)

Kollektorrestströme

$$\begin{array}{lll} -I_{CEO} & \leq 0.1 \, \mu A \ (bei \ -U_{CE} = \ 6 \ V) \\ -U_{CEO} & \leq 1.2 \, V \ (bei \ I_E = 50 \ mA) \end{array}$$

Grenzfrequenz in Basisschaltung

$$f_{h\,21\,b} = 12 \ge 4\,\text{MHz}$$
 (bei — $U_{CB} = 6\,\text{V}$, — $I_{C} = 1\,\text{mA}$)

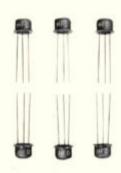
Vierpolwerte in Emitterschaltung

(bei —
$$U_{CE}=6$$
 V, — $I_{C}=1$ mA, $f_{M}=1$ kHz)
 $h_{21\,e}=150 \geq 40$
 $h_{11\,e}=4 \geq 1.3$ k Ω
 $h_{12\,e} \leq 15\ 10^{-4}$
 $h_{22\,e} \leq 300~\mu S$

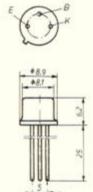
Rauschfaktor

$$F=4 \leq$$
 10 dB (bei —U_CE = 1 V, —I_C = 0,5 mA, f_{M} = 1,2 k $\Omega)$

$$\begin{array}{lll} \textbf{Grenzwerte} & (f \ddot{u} r \; \vartheta_a = 45 \; ^{\circ}\text{C}) \\ & -U_{CE} = 6,6 \; V & P = 250 \; \text{mW} \\ & U_{BE} = 6,6 \; V & \vartheta_j = 150 \; ^{\circ}\text{C} \\ & -I_{C} = 50 \; \text{mA} & \vartheta_s = -40 \ldots + 125 \; ^{\circ}\text{C} \\ & I_{E} = 80 \; \text{mA} \end{array}$$



Abmessungen



Masse ca. 1 g